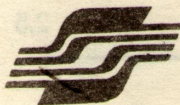


# Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В КТ829Г

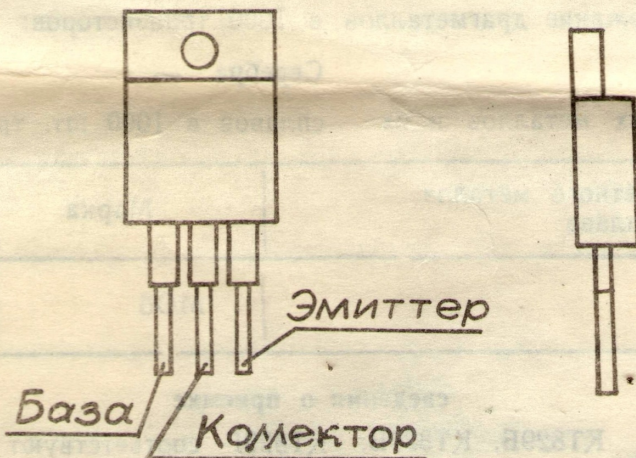


## ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-планарные составные п-р-п мощные транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г в пластмассовом корпусе предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1.5.1

Корпус типа КТ-28-2 по ГОСТ 18472-82



Масса транзистора не более 3 г.

Таблица 1

Основные электрические параметры при T<sub>корп.</sub> = -25 10-гр. С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обознач.	Норма	
		не менее	не более
Статистический коэффициент передачи тока (I <sub>кэ</sub> —3 В, I <sub>к</sub> —3 А)	η <sub>21э</sub>	750	
Обратный ток коллектора, мА	I <sub>кб0</sub>	—	0,2
I <sub>кб</sub> —100В для КТ829А		—	0,2
I <sub>кб</sub> —80 В для КТ829Б		—	0,2
I <sub>кб</sub> —60 В для КТ829В		—	0,2
I <sub>кб</sub> —40 В для КТ829Г		—	0,2
Обратный ток эмиттера (I <sub>эб</sub> —5 В, I <sub>к</sub> —0), мА	I <sub>эб0</sub>		2,0
Граничное напряжение, В	I <sub>кэ0</sub> гр.	100	—
для КТ829А		80	—
для КТ829Б		60	—
для КТ829В		45	—
для КТ829Г			
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (I <sub>к</sub> —3 А, I <sub>б</sub> —0,012 А), В	I <sub>кэ</sub> нас		2



Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_{к-3}$ А, $I_{б-0,012}$ А). В	$I_{бэ}$ нас	—	2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $I_{кэ} - 3$ В, $I_{к-3}$ А, — 10 МГц)	(21э)	0,4	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА	$I_{кэ0}$		
$I_{кэ} - 50$ В для КТ829А		—	0,5
$I_{кэ} - 40$ В для КТ829Б		—	0,5
$I_{кэ} - 30$ В для КТ829В		—	0,5
$I_{кэ} - 20$ В для КТ829Г		—	0,5

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота—0,3347 г Серебра —

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса г.
Медь	МОб	1820 г

#### сведения о приемке

Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г соответствуют техническим условиям ААО. 336. 292ТУ

Штамп

ОТКА-20

Штамп

Государственной приемки

#### Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ 11630-84, ОСТ II 336: 907: 0-79:

Транзисторы необходимо применять с тепловодами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 85 гр. С.

Допускается формировка выводов транзисторов в направлении, перпендикулярном плоскости его основания. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

Формировку проводить с обязательной фиксацией выводов. Место фиксации — между корпусом и местом изгиба.